

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局(43) 国際公開日
2001年6月7日 (07.06.2001)

PCT

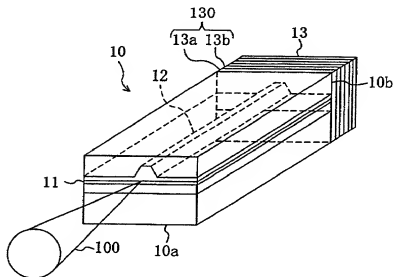
(10) 国際公開番号
WO 01/41271 A1

- (51) 国際特許分類: H01S 5/028, G11B 7/125 (72) 発明者; および
(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 菅原 岳 (SUGAHARA, Gaku) [JP/JP]; 〒631-0806 奈良県奈良市朱雀5-1-1-68-101 Nara (JP). 木戸口 聡 (KITOGUCHI, Isao) [JP/JP]; 〒678-0205 兵庫県赤穂市大町 10-27-A203 Hyogo (JP). 宮永 良子 (MIYANAGA, Ryoko) [JP/JP]; 〒631-0031 奈良県奈良市数島町2-511-11 Nara (JP). 鈴木政勝 (SUZUKI, Masakatsu) [JP/JP]; 〒573-0171 大阪府枚方市北山1-66-4-201 Osaka (JP). 桑 雅博 (KUME, Masahiro) [JP/JP]; 〒520-2276 滋賀県大津市里7-18-3 Shiga (JP). 伴雄三郎 (BAN, Yusaburo) [JP/JP]; 〒573-0171 大阪府枚方市北山1-44-15 Osaka (JP). 平山福一 (HIRAYAMA, Fukukazu) [JP/JP]; 〒678-0164 兵庫県赤穂市目板773-133 Hyogo (JP).
- (21) 国際出願番号: PCT/JP00/08461
- (22) 国際出願日: 2000年11月29日 (29.11.2000)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願平11/339195
1999年11月24日 (30.11.1999) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 松下電器産業株式会社 (MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD.) [JP/JP]; 〒571-8501 大阪府門真市大字門真1006番地 Osaka (JP).
- (51) 指定国 (国内): US.

[続葉有]

(54) Title: SEMICONDUCTOR LASER DEVICE, METHOD FOR PRODUCING THE SAME, AND OPTICAL DISK DEVICE

(54) 発明の名称: 半導体レーザ素子、その製造方法及び光ディスク装置



(57) Abstract: A semiconductor laser device (10) includes a resonator (12) in which a quantum well active layer (11) comprising a barrier layer made of gallium nitride and a well layer made of indium gallium nitride is sandwiched vertically between light guide layers made of at least n- and p-type aluminum gallium nitrides. The output face (10a) and the reflection face (10b) opposed to the output face of the resonator (12) each have a face reflecting film (13). The face reflecting film (13) comprises unit reflecting films (130) each constituted of a low reflectance film (13a) made of silicon oxide and a high reflectance film (13b) made of niobium oxide, both formed in order on the face of the resonator (12).

[続葉有]

102220: 56006860

WO 01/41271 A1